

2024年4月23日

各位

**「高品質8インチSiC単結晶・ウェハの製造技術開発」の  
NEDOグリーンイノベーション基金 助成事業への移行のお知らせ**

当社は、2022年2月25日に「『高品質8インチSiC単結晶・ウェハの製造技術開発』のNEDOグリーンイノベーション基金への採択のお知らせ」にて開示しましたとおり、国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構(以下、NEDO)の「グリーンイノベーション基金事業/次世代デジタルインフラの構築」における、「次世代パワー半導体に用いるウェハ技術開発」への当社テーマ「高品質8インチSiC<sup>\*1</sup>単結晶・ウェハの製造技術開発」が採択され、2022年4月より委託事業として溶液法<sup>\*2</sup>によるSiCウェハの研究開発を進めております。

この度、事業継続の判断を行うNEDOのステージゲート審査の結果、本テーマが2024年4月より助成事業に移行することが決定されましたのでお知らせいたします。

当社は、グリーンイノベーション基金助成事業への移行を機会に、溶液法による高品質、且つコスト競争力のある8インチSiC単結晶の研究開発を加速し、世界トップレベルの高品質8インチSiCウェハの量産化を実現するとともに、その社会実装を通じてカーボンニュートラル社会の構築に貢献してまいります。

＜NEDOグリーンイノベーション基金事業 当社の実施テーマ＞

・プロジェクト名:

(大項目)グリーンイノベーション基金事業/次世代デジタルインフラの構築

(中項目)次世代パワー半導体に用いるウェハ技術開発

(小項目)高品質8インチSiC単結晶・ウェハの製造技術開発

・プロジェクト実施者: セントラル矽子株式会社

・プロジェクト期間: 2022年度～2029年度(最大8年間)

\*1 SiC(炭化ケイ素、シリコンカーバイド): 現在主流のSi(シリコン)に比べ、絶縁破壊電界強度が高く、スイッチング損失が少なく、また、熱伝導率が高いなどの優位性を有することから、高温作動や、電力損失低減が可能な次世代パワー半導体材料

\*2 溶液法: ケイ素及び炭素を含む原料溶液中でSiC結晶を晶出させる手法。SiC単結晶製造において、現在主流の昇華法と比べ、欠陥低減が容易であり、大口径化・長尺化に優位性が有る将来的にコストダウンのポテンシャルが高い製法

以上

《本件に関するお問い合わせ先》

セントラル矽子株式会社

電子材料営業部

TEL: 03-3259-7226